

ВРЕМЯПРОЛЕТНАЯ ФОТОИОНИЗАЦИОННАЯ  
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ ПРОДУКТОВ  
ИК-ДИССОЦИАЦИИ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ МОЛЕКУЛ

С.С. А л и м п и е в, А.М. В е л и ч к о,  
С.М. Н и к и ф о р о в, Г.Л. О д а б а ш я н,  
Б.Г. С а р т а к о в, С.В. С и н ъ к о

Методы времяпролетной фотоионизационной масс-спектрометрии ВФМС многоатомных молекул находят в последние годы широкое применение благодаря высокой чувствительности, избирательности и возможности проводить масс-спектрометрический анализ в существенно нестационарных условиях [1].

Особый интерес представляет использование ВФМС для исследования продуктов многофотонной диссоциации МФД молекул. В отличие от традиционных методов исследования процесса МФД, основанных на анализе конечных продуктов, образующихся в газовой кювете при многократном облучении, метод ВФМС позволяет получать информацию о первичных продуктах МФД сразу после воздействия диссоциирующего ИК-лазерного импульса, т.е. в условиях, заведомо исключающих влияние процессов рекомбинации и вторичных химических реакций, приводящих к образованию конечных продуктов.

В этой работе мы сообщаем об исследовании изотопически селективной диссоциации молекул  $SiF_3CH_3$ ,  $SiF_3CCl_3$ ,  $Si_2OF_6$ ,  $CF_2HCl$  в ИК-лазерном поле методом ВФМС продуктов диссоциации. Интерес к кремнийсодержащим молекулам обусловлен прежде всего поиском оптимальных соединений для лазерного разделения изотопов кремния. Исследование МФД  $CF_2HCl$  представляет в основном методический интерес, поскольку позволяет сравнить данные, полученные методом ВФМС, с литературными данными по МФД этой молекулы, применяемой для лазерного разделения изотопов углерода.

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Для диссоциации молекул использовано два перестраиваемых по частоте ТЕА  $CO_2$ -лазера  $L$  1,  $L$  2, импульсы генерации которых синхронизированы и задержаны друг относительно друга на 100 нс. Это позволяет исследовать режим двухчастотной фотодиссоциации молекул, который, как известно, обеспечивает существенное увеличение селективности и выхода продуктов [2]. Пучки  $CO_2$ -лазеров совмещены с помощью расщепителя  $S$  и фокусируются длиннофокусной линзой  $L$  1 в область ионного источника масс-спектрометра. В экспериментах использован времяпролетный масс-спектрометр рефлектрои [3], изготовленный на базе прибора МСХ-6. Ионный источник масс-спектрометра помещен в вакуумную камеру, снабженную окнами из  $BaF_2$  для ввода лазерного излучения. Исследуемый газ подается через капилляр в область пересечения лазерных пучков. Типичное давление газа в камере  $10^{-5}$ – $10^{-6}$  торр.

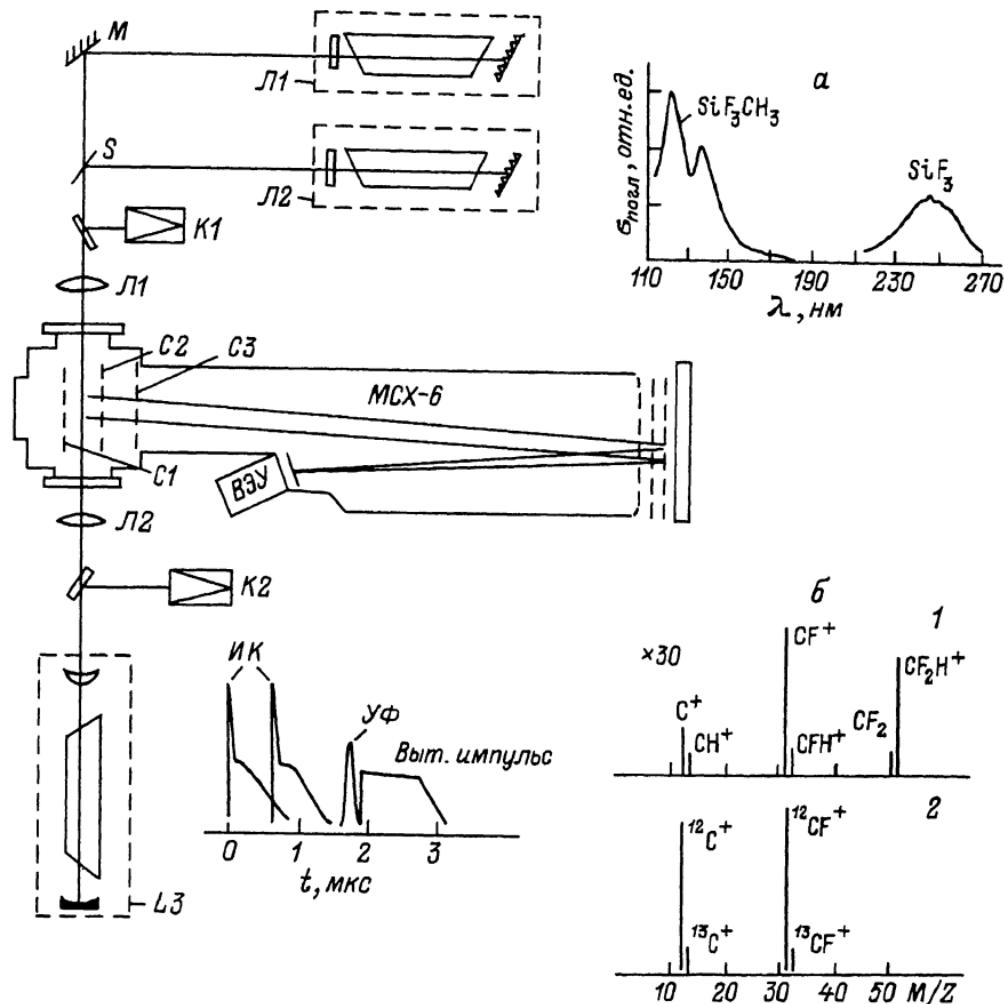


Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

Для фотоионизации продуктов ИК-диссоциации использовано излучение  $\text{KrF}$ -лазера (модель 170 СКБ ИОФАН) с энергией в импульсе около 20 мДж в основной поперечной моде  $\text{TEM}_{00}$ . Пучок эксимерного лазера вводится в камеру навстречу пучкам  $\text{CO}_2$ -лазеров и фокусируется линзой L2. Типичный размер фокальной перетяжки составлял  $0.2 \times 0.3$  мм, что позволяло достигать интенсивности ионизирующего излучения  $1 \approx 5 \times 10^8 \text{ Вт}/\text{см}^2$ . Импульс излучения  $\text{KrF}$ -лазера синхронизован по времени с импульсами  $\text{CO}_2$ -лазеров и выталкивающим импульсом масс-спектрометра, который прикладывается к сеткам C1, C2 ионного источника. Образовавшиеся ионы после прохождения ускоряющего промежутка  $\text{C}_2-\text{C}_3$  и свободного пролета с отражением от ионного зеркала 3 регистрируются с помощью ВЭУ. Получаемый таким образом масс-спектр регистрируется

цифровым осциллографом С9-8, совмещенным с микроКомпьютером 666/В.

Существенными преимуществами фотоионизационного метода по сравнению с ионизацией электронным пучком является, во-первых, возможность пространственного совмещения пучков ИК и УФ излучения, что позволяет производить ионизацию продуктов лишь в зоне диссоциации молекул ИК-излучением, во-вторых, избирательность фотоионизационного метода, основанная на существенном различии УФ спектров и сечений фотоионизации исходных молекул и продуктов ИК-диссоциации. Спектры УФ поглощения молекулы  $\text{SiF}_3\text{CH}_3$  и радикала  $\text{SiF}_3$  [4, 5] приведены на рис. 1, а. Видно, что в области 249 нм радикал  $\text{SiF}_3$  имеет полосу УФ поглощения, что и обеспечивает преимущественную фотоионизацию радикала на этой длине волн в результате многоступенчатого поглощения квантов УФ излучения. В эксперименте фотоионизация радикалов  $\text{SiF}_3$  наблюдалась по появлению ионных пиков  $^{28, 29, 30}\text{SiF}^+$ , при ИК диссоциации молекул  $\text{SiF}_3\text{CH}_3$ ,  $\text{SiF}_3\text{CCl}_3$  и пиков  $\text{SiO}^+$ ,  $\text{SiF}^+$  при ионизации радикала  $\text{SiOF}_2$ , продукта диссоциации  $\text{Si}_2\text{OF}_6$ . Амплитуда ионных пиков  $\text{SiF}^+$  увеличивалась квадратично с ростом интенсивности УФ-излучения, при этом вплоть до максимальных интенсивностей УФ- поля фотоионизации исходных молекул не наблюдалось.

Фотодиссоциация молекул  $\text{CF}_2\text{HCl}$  производилась в диапазоне частот  $\text{CO}_2$ -лазера 1033–1085  $\text{cm}^{-1}$ . Образующийся при этом радикал  $\text{CF}_2$  также имеет полосу УФ поглощения вблизи 250 нм [6] и легко ионизуется излучением  $\text{KrF}$ -лазера, давал ионные пики  $\text{C}^+$  и  $\text{CF}^+$ . Однако в отличие от предыдущих молекул при увеличении интенсивности УФ-излучения наблюдалась, хотя и с существенно меньшим сечением, фотоионизация исходных молекул  $\text{CF}_2\text{HCl}$  с образованием ионных пиков  $\text{C}^+\text{CH}^+$ ,  $\text{CF}^+$ ,  $\text{CFH}^+$ ,  $\text{CF}_2^+$ ,  $\text{CF}_2\text{H}^+$ . Дополнительный источник ионов  $\text{C}^+$  и  $\text{CF}^+$  затрудняет регистрацию радикала  $\text{CF}_2$ , однако этот вклад может быть учтен, поскольку он пропорционален амплитудам пиков  $\text{CF}_2^+$  или  $\text{CF}_2\text{H}^+$ , не связанных с фотоионизацией радикала  $\text{CF}_2$ . Типичный вид фотоионизационных масс-спектров  $\text{CF}_2\text{HCl}$  в отсутствии диссоциирующего ИК- поля 1 и при 5% диссоциации  $\text{CF}_2\text{HCl}$  и регистрации радикала  $\text{CF}_2$  2 приведены на рис. 1, б. Следует отметить, что наблюдаемые в эксперименте пороговые зависимости образования радикала  $\text{CF}_2$  от интенсивности ИК-лазерного поля хорошо соответствуют данным работ [7, 8] по МФД  $\text{CF}_2\text{HCl}$ .

На рис. 2 представлены результаты исследования изотопически селективной ИК-диссоциации молекул  $\text{SiF}_3\text{CH}_3$ . Основные частоты колебаний  $\text{SiF}_3\text{CH}_3$  известны из работы [9]. ИК-лазерное поле настраивалось в резонанс с валентным колебанием  $\nu_{10}$  связи  $\text{Si}-\text{F}$  ( $= 969 \text{ cm}^{-1}$ )  $^{30}\text{SiF}_3\text{CH}_3$ . Величина изотопического сдвига этого колебания была измерена по ИК-спектрам газа  $\text{SiF}_3\text{CH}_3$ , растворенному в жидким кремните, и составила  $\Delta\nu = 8.2 \pm 0.1 \text{ cm}^{-1}$  на единицу массы кремния. Кривые 1–3 соответствуют зависимостям выходов диссоциации  $\text{SiF}_3\text{CH}_3$ , измеренным по амплитудам ионных пиков  $^{28}\text{SiF}^+$ ,  $^{29}\text{SiF}^+$ ,  $^{30}\text{SiF}^+$  от суммарной плотности

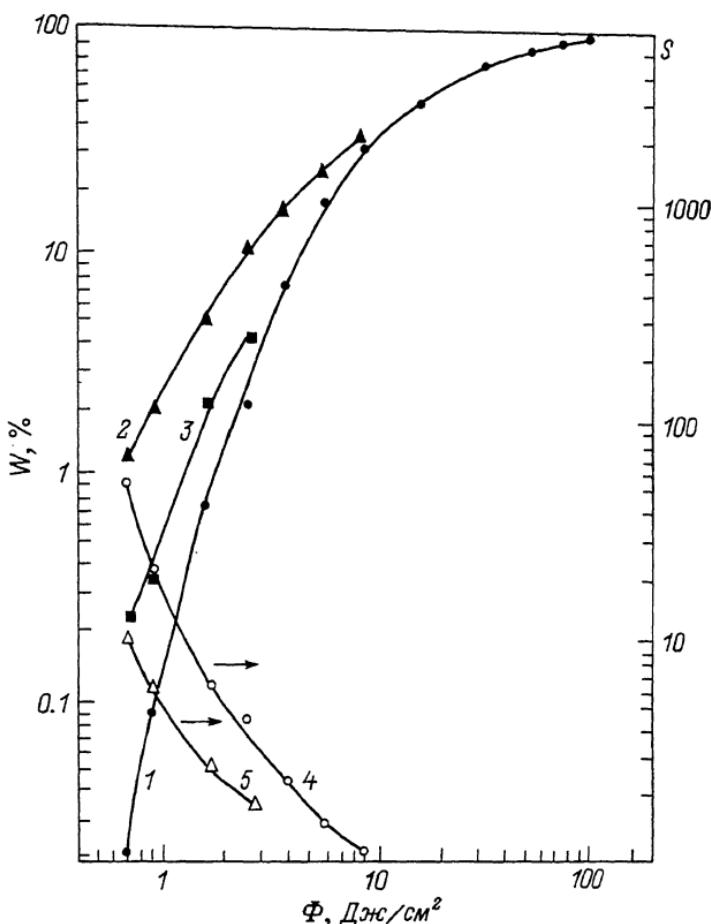


Рис. 2. 1-3 – зависимости выхода диссоциации различных изотопических компонент молекулы  $\text{SiF}_3\text{CH}_3$ ,  $^{28}\text{Si}$ ,  $^{29}\text{Si}$ ,  $^{30}\text{Si}$  соответственно в двухчастотное поле от плотности энергии суммарного лазерного поля при фиксированном первом поле  $\nu_1 = 951.19 \text{ см}^{-1}$ ,  $\Phi_1 = 0.3 \text{ Дж}/\text{см}^2$ ,  $\nu_2 = 923 \text{ см}^{-1}$ ; 4-5 – зависимости изотопической селективности компонент  $^{30}\text{Si}$ ,  $^{29}\text{Si}$  соответственно от плотности энергии лазерного поля.

энергии двух ИК-лазерных полей в условиях двухчастотной диссоциации молекул  $\text{SiF}_3\text{CH}_3$ . Насыщение кривой 1 при значительном увеличении плотности энергии ИК-поля являются следствием 100% диссоциации молекул и позволяет провести калибровку выходов диссоциации. Из кривых 1-3 может быть вычислена изотопическая селективность ИК МФД  $S_{29,30} = \frac{W_{29,30}}{W_{28}}$ , определяемая отношением выходов диссоциации различных изотопических компонент. Зависимости селективности по изотопам  $^{29}\text{Si}$  и  $^{30}\text{Si}$  от плотности энергии ИК-лазерного поля приведены в нижней части рис. 2 (кривые 4, 5), из которых видно, что для молекулы  $\text{SiF}_3\text{CH}_3$  в условиях двухчастотного воздействия достигается селективность  $S_{30} = 60$

при выходе диссоциации целевого изотопа  $W_{30} = 1\%$ . С увеличением плотности энергии селективность ИК-диссоциации постепенно уменьшается, стремясь к величине  $S_{30} = 1$ .

Аналогичные исследования, выполненные для молекул  $Si_2OF_6$  и  $SiF_3CCl_3$ , при оптимальном выборе частот лазерного воздействия на изотопическую компоненту  $^{30}Si$ , дали следующие результаты: для  $Si_2OF_6$   $W_{30} = 5\%$ ,  $S_{30} = 30$ , при  $\nu_1 = 968 \text{ см}^{-1}$   $\Phi = 0.25 \text{ Дж/см}^2$ ,  $\nu_2 = 955 \text{ см}^{-1}$   $\Phi = 0.25 \text{ Дж/см}^2$ , а для  $SiF_3CCl_3$ ,  $S_{30} = 40$  при  $\Phi$  ( $W_{30} = 1\%$ ) =  $0.1 \text{ Дж/см}^2$ ,  $\nu = 985 \text{ см}^{-1}$ .

Таким образом, проведенные исследования показывают возможности метода ВФМС не только для качественного масс-спектрометрического анализа продуктов диссоциации, но и измерения выходов диссоциации и ее изотопической селективности. Результаты измерений селективности и выходов диссоциации исследованных кремний-содержащих молекул свидетельствуют о перспективности их использования для целей лазерного разделения изотопов.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Летохов В.С. Лазерная фотоионизационная спектроскопия. М.: Наука, 1987, 320 с.
- [2] Алимпиев С.С., Карлов Н.В., Крынечкий Б.Б., Петров Ю.Н. Лазерное разделение изотопов. - ВИНИТИ, Итоги науки и техники, 1980, т. 22.
- [3] Мамырин Б.А., Карадаев В.И., Шмик Д.В. - Загулин В.А. - ЖЭТФ, 1973, т. 64, с. 82-89.
- [4] I b u k i T., W a s h i d a N., I t o h U., T o y o o s h i m a Y. and O n i k i H. - Chem. Phys. Lett., 1987, v. 136, p. 447-450.
- [5] L i n g - F a i W a n g J., K r i s h - n a n C.N., M a r g r a v e J.L. - J. Mol. Spectrosc., 1973, v. 48, p. 346-353.
- [6] S h a r p e S., H a r t n e t t B., S e t - t i H.S., S e t t i D.S. - J. Phaotochem., 1987, v. 38, p. 1-13.
- [7] G a n t h i e r M., C u r e t o n C., H a c k e t t P.A., W i l l i s C. - Appl. Phys. B., 1982, v. 28, p. 43-50.
- [8] Евсеев А.В., Пурецкий Д.А. - Квантовая электроника, 1985, т. 12, с. 1050-1054.
- [9] Синько С.В., Курамшина Г.М., Протасов Е.М., Гольдин Г.С., Пентин Ю.А., Башкирова С.А. - Вестн. МГУ, сер. 2, химия, 1983, т. 24, с. 449-452.

Поступило в Редакцию  
19 июля 1988 г.